

**Transistor IRF640N MOSFET N 200V 18A**

**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : SAVIRF640N



Transistor IRF640N MOSFET N 200V 18A

Polarité transistor Canal N  
 Courant de drain Id 18A  
 Tension Vds max.. 200V  
 Résistance Rds(on) 0.15ohm  
 Tension, mesure Rds 10V  
 Tension de seuil Vgs 4V  
 Dissipation de puissance Pd 150W  
 Type de boîtier de transistor TO-220AB  
 Température max.. 175°Ca

**Packaging :**

Dimensions produit : 1mm X 1mm X Ø 1mm Poids : 1g

*Données non contractuelles*